

	<p>SI7858BDP-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI7858BDP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 12V 40A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7858BDP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 37 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7858BDP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 12V 40A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	37 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 mOhm @ 15A, 4.5V
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 48W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SI7858BDP-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5760pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	84nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 12V 40A (Tc) 5W (Ta), 48W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

SI7858BDP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7858BDP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7858BDP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7858BDP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7858BDP VB SI7858BDP VB</p>	 <p>SI7858BDP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7858BDP-T1-E3 VISHAY SI7858BDP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI7860ADP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 11A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7860ADP SI SI7860ADP SI</p>	 <p>SI7860ADP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 11A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7858DP-T1 VISHAY SI7858DP-T1 VISHAY</p>	 <p>SI7858ADP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 20A PPAK SO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI7858BDP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7858BDP-T1-GE3 Datenblatt	SI7858BDP-T1-GE3-Datenblätter	SI7858BDP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7858BDP-T1-GE3
SI7858BDP-T1-GE3 Electronic	SI7858BDP-T1-GE3-Komponenten	SI7858BDP-T1-GE3-Verteiler	SI7858BDP-T1-GE3-Bild	SI7858BDP-T1-GE3-Teil
SI7858BDP-T1-GE3 Preis	SI7858BDP-T1-GE3 Hersteller	SI7858BDP-T1-GE3 Bild	SI7858BDP-T1-GE3 Aktie	SI7858BDP-T1-GE3 Inventar
SI7858BDP-T1-GE3 Neu	SI7858BDP-T1-GE3 Original	SI7858BDP-T1-GE3 garantiert	SI7858BDP-T1-GE3 RFQ	SI7858BDP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited